查询2SD947供应商 捷多邦，专业PCB打样工厂，24小时加急出货

T-33-29

2SD947

エピタキシアルプレーナ形 NPN シリコンダーリントントランジスタ
低周波電力増幅用/Low Freq. Power Amp.
Epitaxial Planar NPN Silicon Darlington Transistor

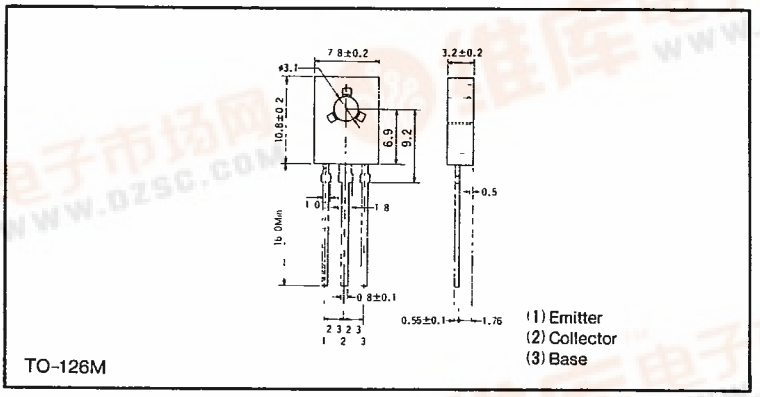
● 特長

1) ダーリントン接続で高h_{FE}である。
2) BE間に約4kΩの抵抗を内蔵。温度安定性がよい。
3) 裏面もモールドで覆われており，絶縁が不要である。

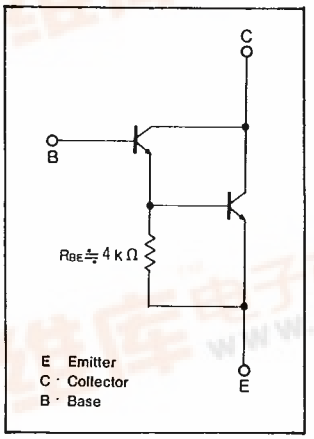
● Features

1) Darlington connection provides high DC current in (h_{FE})
2) Built-in resistance of approx. 4kΩ between its base and emitter. Exellent temperature stability.
3) The rear surface of this device is also molded, eliminating the need for insulation.

● 外形寸法図／Dimensions (Unit : mm)



● 内部等価回路図



● 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CER}	40	V (R_{BE}=10kΩ)
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	2	A
コレクタ損失	P_C	5	W (Tc=25℃)
		1.2	W (Ta=25℃)
接合部温度	Tj	150	℃
保存温度範囲	Tstg	−55～150	℃

● 電気的特性／Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CER}	40	—	—	V	I_C=1mA, R_{BE}=10kΩ
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	40	—	—	V	I_C=50μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	5	—	—	V	I_E=50μA
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	—	—	1.0	μA	V_{CB}=24V
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	—	—	1.0	μA	V_{EB}=4V
直流電流増幅率	h_{FE}	4 000	—	—	—	V_{CE}/I_C=3V/500mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	0.80	1.5	V	I_C/I_B=600mA/1.2mA
利得帯域幅積	f_T	—	150	—	MHz	V_{CE}=6V, I_E=−100mA
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	11	—	pF	V_{CB}=10V, I_E=0A, f=1MHz

● 標準品・準標準品一覧表 (◎：標準品 ○：準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	バルク
		記号	
		基本発注単位(個)	1 000
2SD947	4K～		◎

トランジスタ 2SDタイプ

找PDF 维库一下 pdf.dzsc.com

● 電気的特性曲線／Electrical Characteristic Curves

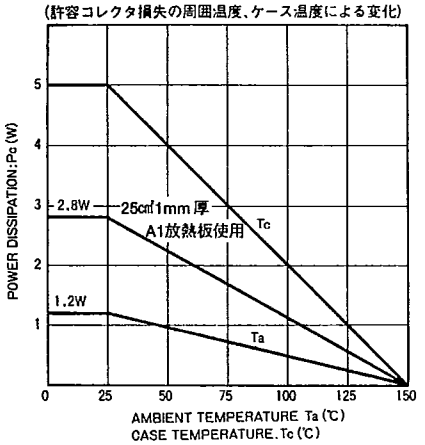


Fig.1 電力軽減曲線

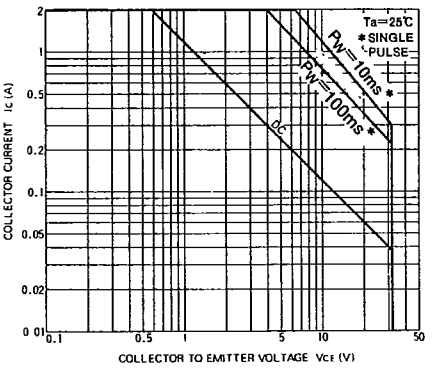


Fig.2 安全動作領域

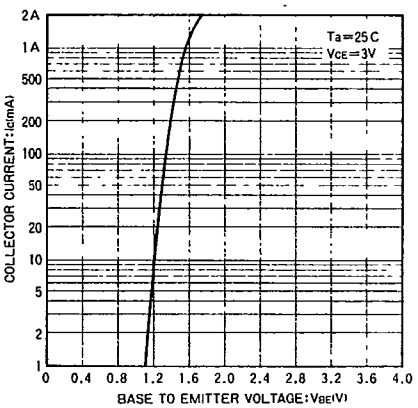


Fig.3 エミッタ接地伝達静特性

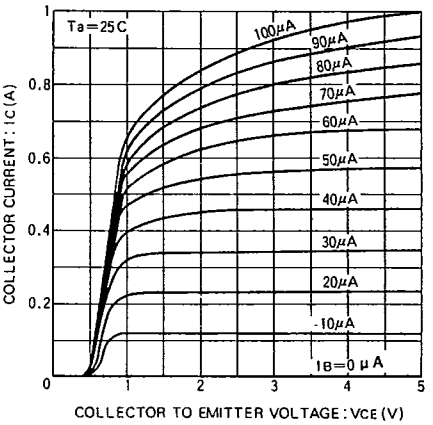


Fig.4 エミッタ接地出力静特性

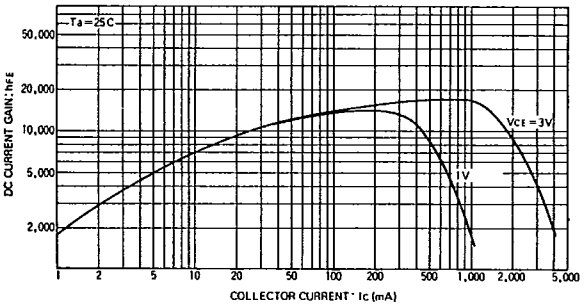


Fig.5 直流電流増幅率ーコレクタ電流特性

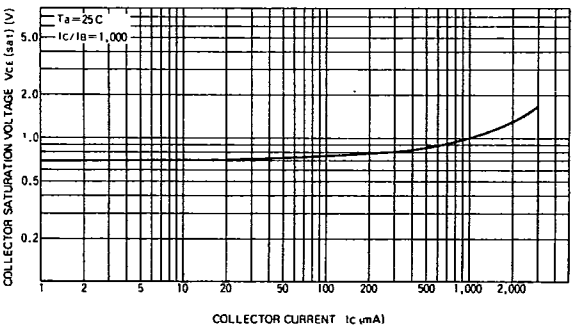


Fig.6 コレクタ・エミッタ飽和電圧ーコレクタ電流特性

T-27-15

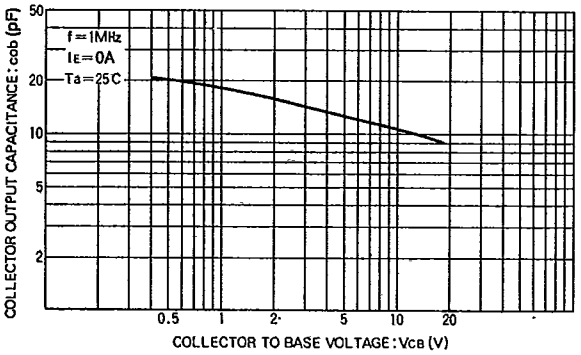


Fig.8 エミッタ入力容量—エミッタ·ベース電圧特性

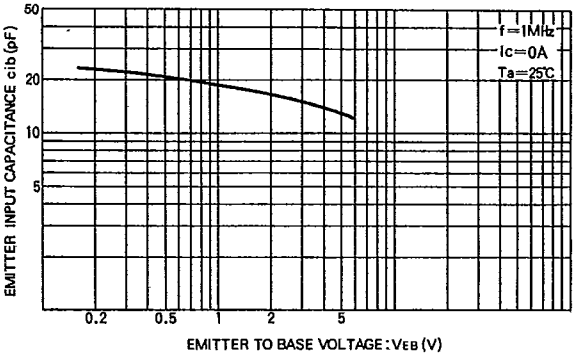


Fig.7 コレクタ出力容量—コレクタ·ベース電圧特性

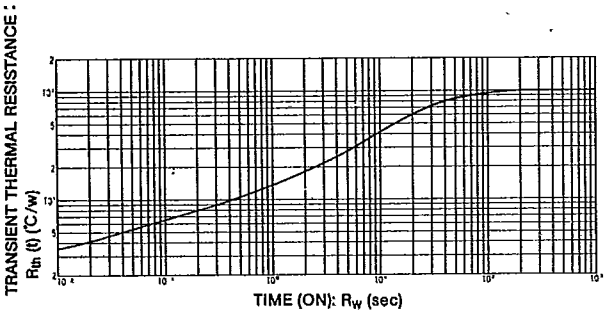


Fig.9 過渡熱抵抗